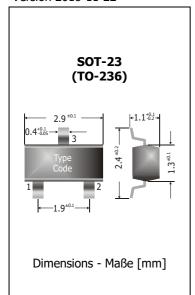


BAS70, BAS70-04, BAS70-05, BAS70-06

SMD Small Signal Schottky Diodes SMD Kleinsignal-Schottkydioden

Version 2018-11-22



Typical Applications

Signal processing, High-speed switching, Polarity protection Commercial grade Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹) Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹) Suffix

Features

Very high switching speed Low junction capacitance Low leakage current Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled 3000 / 7"
Weight approx. 0.01 g
Solder & assembly conditions 260°C/10s

MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung, Schnelles Schalten, Verpolschutz Standardausführung Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹) Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹)

Besonderheiten

Extrem schnelles Schalten Niedrige Sperrschicht-Kapazität Niedriger Sperrstrom Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹)

Mechanische Daten 1)

Gegurtet auf Rolle Gewicht ca.

Löt- und Einbaubedingungen

BAS70			BAS70-04/-Q			
Single Diode	3	Type Code 73	Series Connection	3 1 2	Type Code 74	
	$1 = A \ 2 = n. \ c. \ 3 = C$			1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2		
BAS70-05/-Q			BAS70-06			
Common Cathode	3 1 2	Type Code 75	Common Anode	3 1 2	Type Code 76	
	1 = A1 2 = A2 3 = C1/C2			1 = C1 $2 = C2$ $3 = A1/A2$		

Maximum ratings ²) Grenzwerte ²)

Power dissipation – Verlustleistung ³)		P _{tot}	200 mW ⁴)
Max. average forward current – Dauergrenzstrom	DC	I_{FAV}	70 mA ⁴)
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom		I_{FRM}	70 mA ⁴)
Non repetitive peak forward surge current – Stoßstrom-Grenzwert $t_p \le 1 \text{ s}$		\mathbf{I}_{FSM}	100 mA
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung		V_{RRM}	70 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _S	-55+150°C -55+150°C

¹ Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die <u>detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite</u> bzw. am Anfang des Datenbuches

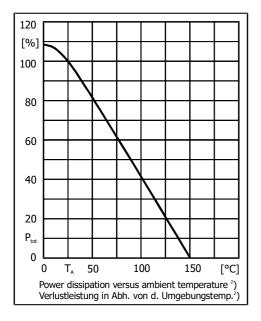
 $T_A = 25$ °C and per diode, unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C und pro Diode, wenn nicht anders angegeben

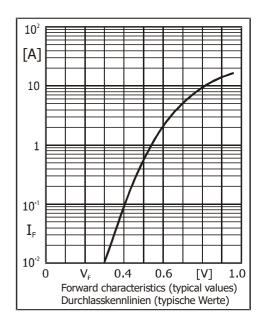
³ Total power dissipation of both diodes – Summe der Verlustleistungen beider Dioden

⁴ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss



Characteristics				Kennwerte
Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^{\circ}C$	$I_F = 1 \text{ mA}$ $I_F = 15 \text{ mA}$	V _F	< 410 mV < 1000 mV
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^{\circ}C$	$V_R = 50 \text{ V}$	\mathbf{I}_{R}	< 100 nA ¹)
Breakdown voltage Abbruchspannung	$T_j = 25^{\circ}C$	$I_R = 10 \ \mu A$	V_{BR}	> 70 V ¹)
Max. junction capacitance Max. Sperrschichtkapazität	V _R = 0 V, f = 1 MHz		Ст	2 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	I_{F} = 10 mA über/through I_{R} = 10 mA bis/to I_{R} = 1 mA		t _{rr}	< 5 ns
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R _{thA}	625 K/W ²)





Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

2

¹ Tested with pulses t_p = 300 μ s, duty cycle \leq 2% Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μ s, Schaltverhältnis \leq 2%

² Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss